

Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации	Лаборатория Космического материаловедения ИК РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук
Сокращенное наименование организации	ЛКМ ИК РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
Место нахождения	г. Калуга
Почтовый адрес	248640, Россия, Калуга, ул. Академическая, дом 8
Телефон, адрес электронной почты, сайт	т. 8 (4842) 76-27-67, e-mail: kmikran@spark-mail.ru, http://www.crys.ras.ru

Список публикаций работников по теме диссертации за последние 5 лет

1. Михеев Н. Н., Никифорова Н. А., Ганчев А. С. Латеральное распределение потерь энергии пучка электронов в веществе при нормальном падении заряженных частиц на поверхность образца // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 9. С. 64.
2. Никифорова Н.А., Степович М.А., Михеев Н. Н. Измерение диффузионной длины и времени жизни свободных экситонов в нитриде галлия катодоллюминесцентным методом при различных условиях возбуждения люминесценции // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 8. С. 84.
3. Михеев Н.Н., Степович М.А., Широкова Е.В., Филиппов М.Н. Методика количественного рентгеноспектрального микроанализа с учетом матричных эффектов // Перспективные материалы. 2014. № 2. С. 77-81.
4. Михеев Н.Н. Решение прямой задачи количественного рентгеноспектрального микроанализа для бинарных сплавов известного состава // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. № 9. С. 66.
5. Заблоцкий А.В. , Кузин А.Ю. , Михеев Н.Н., Степович М.А., Тодуа П.А. , Широкова Е.В., Филиппов М.Н. Учет матричных эффектов при измерениях методом рентгеноспектрального микроанализа // Измерительная техника. 2013. № 7. С. 58-61.
6. Заблоцкий А.В., Кузин А.Ю., Михеев Н.Н., Никифорова Н.А., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н. Модель квадратичной рекомбинации неосновных носителей заряда в прямозонных полупроводниках для катодоллюминесцентной идентификации электрофизических параметров // Нано- и микросистемная техника. 2013. № 6. С. 10-12.
7. Никифорова Н.А., Поляков А.Н., Михеев Н.Н., Степович М.А. О выборе начального приближения в методе конфлюэнтного анализа для катодоллюминесцентной идентификации параметров прямозонных полупроводниковых материалов при квадратичной рекомбинации неосновных носителей заряда // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 11. С. 60.
8. Михеев Н.Н., Степович М.А., Широкова Е.В. Распределение средних потерь энергии пучка электронов по глубине образца: применение в задачах количественного рентгеноспектрального микроанализа // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 12. С. 84.
9. Gagarin Yu.E., Mikheev N.N., Nikiforova N.A., Stepovich M.A. Some features of estimation of the diffusion length of minority carriers in cathodoluminescence microscopy // Pro-

- ceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL. 2013. P. 344-345.
10. Михеев Н.Н., Степович М. А., Широкова Е.В. Учет матричных эффектов при локальном электронно-зондовом анализе с использованием новой модели функции распределения по глубине рентгеновского характеристического излучения // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2012. Т. 76. № 9. С. 1086.
 11. Михеев Н.Н., Степович М.А., Широкова Е.В. Новый способ расчета матричных поправок в рентгеноспектральном микроанализе // Прикладная физика. 2012. № 2. С. 31-35.
 12. Chibiryayev A.M., Kozhevnikov I.V., Martyanov O.N. High-temperature reaction of SiO₂ with methanol: nucleophilic assistance of some n-unsubstituted benzazoles // Applied Catalysis A: General. 2013. V. 456. P. 159-167.
 13. Filatova E.O., Sokolov A.A., Yegorova Y.V., Konashuk A.S., Vilkov O.Y., Shulakov A.S., Kozhevnikov I.V., Schaefers F., Gorgoi M. X-ray and photoelectron spectroscopic nondestructive methods for thin films and interfaces study application to SRTiO₃ based heterostructures // Microelectronic Engineering. 2013. V. 109. P. 13-16.
 14. Filatova E.O., Sokolov A.A., Kozhevnikov I.V. Characterization of high-k dielectric internal structure by x-ray spectroscopy and reflectometry: new approaches to interlayer identification and analysis // High-k gate dielectrics for CMOS technology / Ed. by Gang He and Zhaoqi Sun. Weinheim, 2012. P. 225-271.